

**Российская конференция и школа
молодых ученых
по актуальным проблемам
полупроводниковой фотоэлектроники
(с участием иностранных ученых)**

ФОТОНИКА 2021

4-8 октября 2021 г., Новосибирск

ПРОГРАММА

НОВОСИБИРСК-2021

ОРГАНИЗАТОРЫ



Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук

Веб-сайт: www.isp.nsc.ru



Сибирское отделение Российской Академии Наук

Веб-сайт: www.sbras.ru

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОВОДИТСЯ ПРИ СОДЕЙСТВИИ



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Веб-сайт: minobrnauki.gov.ru

СПОНСОРЫ



ООО "МИНАТЕХ" (микро и нано технологии)

Веб-сайт: www.minateh.ru

www.minateh-spare.ru



ZEISS Russia & CIS (ООО «Карл Цейсс»)

Веб-сайт: www.zeiss-solutions.ru

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

Председатель конференции

Латышев А.В. ИФП СО РАН, Новосибирск

Зам. председателя

Двуреченский А.В. ИФП СО РАН, Новосибирск

Милёхин А.Г. ИФП СО РАН, Новосибирск

Ученый секретарь

Аржанникова С.А. ИФП СО РАН, Новосибирск

Члены программного комитета

Абрамов П.И. НПО Орион

Асеев А.Л. ИФП СО РАН, Новосибирск

Балоев В.А. АО «НПО «ГИПО», Казань

Гапоненко С.В. Институт физики НАН Беларуси, Минск

Гладышев А.И. Президиум РАН, Москва

Егоров А.Ю. ООО «Коннектор Оптикс», Санкт-Петербург

Жуков А.Е. СПб АУ НОЦНТ РАН, Санкт-Петербург

Иванов С.В. ФТИ им. А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург

Ивченко Е.Л. ФТИ им. А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург

Исюк В.И. ОАО НЗПП с ОКБ, Новосибирск

Новиков А.В. ПАО "Красногорский завод им. С.А. Зверева", Красногорск

Каргин Н.И. НИЯУ МИФИ, Москва

Красильник З.Ф. ИФМ РАН, Н. Новгород

Красников Г.Я. ПАО «НИИМЭ и Микрон», Зеленоград

Копьев П.С. ФТИ им. А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург

Кукушкин И.В. ИФТТ РАН, Черноголовка

Лукичев В.Ф. ФТИАН, Москва

Маркович Д.М. СО РАН, Новосибирск

Неизвестный И.Г. ИФП СО РАН, Новосибирск

Парамонова В.Ю. АО "НПФ "Микран", Томск

Сауров А.Н. ИНМЭ РАН, Москва

Сидоров Ю.Г. ИФП СО РАН, Новосибирск

Сизов Ф.Ф. ИФП НАН Украины, Киев

Сучков К.И. МНИИРИП, Мытищи, Московская обл.

Терехов А.С. ИФП СО РАН, Новосибирск

Устинов В.М. НТЦ микроэлектроники РАН, Санкт-Петербург

Федорук М.П. НГУ, Новосибирск

Хлыстов И.В. АО "ОКТАВА", Новосибирск

Хохлов Д.Р. МГУ, Москва

Шевцов М.А. ОАО "НПО Геофизика-НВ", Москва

Шпак В.В. Минпромторг, Москва

Чаплик А.В. ИФП СО РАН, Новосибирск

Шалагин А.М. ИАиЭ СО РАН, Новосибирск

Шулунов А.Н. АО «РТИ», Москва

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Сопредседатели

Каламейцев А.В. ИФП СО РАН, Новосибирск
Якушев М.В. ИФП СО РАН, Новосибирск

Зам. председателя

Девяткин П.Т. ИФП СО РАН, Новосибирск
Чурилов С.М. Филиал ИФП СО РАН «КТИПМ», Новосибирск

Ученый секретарь

Аржанникова С.А. ИФП СО РАН, Новосибирск

Члены оргкомитета

Башкатов А.С. МНИИРИП, Мытищи, Московская обл.
Бетеров И.И. ИФП СО РАН, Новосибирск
Бурлаков И.Д. АО «НПО «Орион», Москва
Войцеховский А.В. ТГУ, Томск
Гайслер В.А. ИФП СО РАН, Новосибирск
Грибков В.П. ИФП СО РАН, Новосибирск
Дворецкий С.А. ИФП СО РАН, Новосибирск
Журавлев К.С. ИФП СО РАН, Новосибирск
Карпов В.В. ОАО «Швабе – Фотосистемы», Москва
Кремис И.И. Филиал ИФП СО РАН «КТИПМ», Новосибирск
Кучинская П.А. ИФП СО РАН, Новосибирск
Паршин А.С. СибГУ им. М.Ф. Решетнева, Красноярск
Потатуркин О.И. ИАиЭ СО РАН, Новосибирск
Рябцев И.И. ИФП СО РАН, Новосибирск
Сидоров Г.Ю. ИФП СО РАН, Новосибирск
Тимофеев В.А. ИФП СО РАН, Новосибирск
Тычинская С.А. ИФП СО РАН, Новосибирск
Федоринин В.Н. Филиал ИФП СО РАН «КТИПМ», Новосибирск
Шевырин А.А. ИФП СО РАН, Новосибирск

Адрес и контакты Программного и Оргкомитета комитетов

ФГБУН Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН
пр. ак. Лаврентьева 13, 630090, Новосибирск,

Факс: +7(383) 333-27-71; e-mail: photonics2021@isp.nsc.ru

Ученый секретарь - Аржанникова София Андреевна, тел.: +7(383) 333-24-88

РОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ПО АКТУАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ ФОТОЭЛЕКТРОНИКИ

Конференц-зал ИФП СО РАН

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ОКТЯБРЯ

9⁰⁰-10⁰⁰ Регистрация участников конференции

1-е заседание Председатель – Двуреченский А.В.

- 10⁰⁰ – 10¹⁵ Открытие конференции и школы. Вступительное слово.
Академик А.В. Латышев
- 10¹⁵ – 10⁴⁵ Ю.Г.Сидоров¹, М.В.Якушев¹, И.В.Сабинаина¹, **Г.Ю.Сидоров¹**,
В.В.Васильев¹, Д.В.Марин¹, С.А.Дворецкий¹, Н.Н.Михайлов¹,
В.С.Варавин¹, Д.Г.Икусов¹, А.В.Зверев¹, Ю.С.Макаров¹,
А.В.Предеин¹, И.В.Марчишин¹, А.В.Вишняков¹, В.Г.Ремесник¹,
Д.В.Горшков¹, А.В.Латышев¹, П.А. Сысоев², К.С. Лопаткин².
Полный цикл разработки и производства современных охлаждаемых
ИК ФПУ на основе КРТ в ИФП СО РАН (**приглашенный доклад**)
¹ Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН,
Новосибирск;
² Филиал 46 ЦНИИ МО РФ, Мытищи.
- 10⁴⁵ – 11¹⁵ **В.В.Преображенский**, И.Б.Чистохин, М.А.Путятю, Н.А.Валишева,
М.О.Петрушков, А.С.Плешков, И.Г.Неизвестный, И.И.Рябцев
Конструкция и особенности изготовления детектора одиночных
фотонов на базе лавинного фотодиода InP/InGaAs/InP для
квантовых коммуникаций (**приглашенный доклад**)
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН,
Новосибирск
- 11¹⁵ – 11³⁰ Кофе-брейк

2-е заседание Председатель – Милёхин А.Г.

- 11³⁰ – 11⁴⁵ **Б.Г.Вайнер^{1,2}**.
Применение современной ИК термографии для изучения скорости
пульсовой волны.
¹ Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН,
Новосибирск;
² Новосибирский государственный университет, Новосибирск.
- 11⁴⁵ – 12⁰⁰ С.Н.Подлесный¹, И.А.Карташов¹, С.М.Тарков¹, В.А.Володин¹,
В.П.Попов¹, И.Н.Куприянов², Ю.Н.Пальянов², А.А.Емельянов³,
Н.И.Тимошенко³, А.К.Ребров³.
Квантовые сенсоры физических полей на ансамблях NV центров в
алмазных наноструктурах.
¹ Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН,
Новосибирск;
² Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН,
Новосибирск;
³ Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН,
Новосибирск.

- 12⁰⁰ – 12¹⁵ **Т.С.Шамирзаев**¹, М.С.Кузнецова², К.В.Кавокин², Д.С.Смирнов³, J.Rautert⁴, Д.Р.Яковлев^{3,4}, М.Bayer^{3,4}.
Электрон-ядерное взаимодействия в X долине гетероструктур (In,Al)As/AlAs.
¹ Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск;
² Санкт-Петербургский государственный университет, Петергоф;
³ Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе, Санкт-Петербург;
⁴ Technische Universität Dortmund, Dortmund, Germany.
- 12¹⁵ – 12³⁰ **И.Ю.Гензе**¹, М.С.Аксенов², Н.А.Валишева², Д.В.Дмитриев².
Влияние состава слоёв металлизации и отжига в формовочном газе на параметры барьеров Шоттки на основе In_{0.52}Al_{0.48}As.
¹ Новосибирский государственный университет, Новосибирск;
² Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск.
- 12³⁰ – 12⁴⁵ **Е.А.Емельянов**, М.О.Петрушков, И.Д.Лошкарёв, А.В.Васев, Б.Р.Семягин, М.А.Путятю, В.В.Преображенский
МЛЭ твёрдых растворов GaP_xAs_{1-x} на вицинальных подложках: влияние отклонения на состав плёнок.
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск.
- 12⁴⁵ – 13⁰⁰ **А.Э.Климов**^{1,2}, В.А.Голяшов^{1,3}, Д.В.Горшков¹, Н.С.Пацин¹, Г.Ю.Сидоров¹, С.П.Супрун¹, В.Н.Шерстякова¹, О.Е.Терещенко^{1,3}.
Чувствительность плёнок PbSnTe:In к тепловому излучению низкотемпературных (вплоть до T=60K) источников.
¹ Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск;
² Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск;
³ Новосибирский государственный университет, Новосибирск.
- 13⁰⁰ – 13¹⁵ **М.О.Петрушков**¹, Е.А.Емельянов¹, М.А.Путятю¹, А.В.Васев¹, А.К.Бакаров¹, А.К.Гутаковский¹, О.С.Комков², Д.Д.Фирсов², Д.С.Абрамкин¹, В.В.Преображенский¹
Искусственные подложки GaAs/Si(001), выращенные методом молекулярно-лучевой эпитаксии, для оптоэлектронных приложений.
¹ Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск;
² ЛЭТИ, Санкт-Петербург.
- 13¹⁵ – 14³⁰ Обед

3-е заседание Председатель – Якушев М.В.

- 14³⁰ – 15⁰⁰ **В.И.Гавриленко**¹, Р.А.Хабибуллин²
Российские квантовые каскадные лазеры ТГц диапазона (приглашенный доклад)
¹ Институт физики микроструктур РАН, Нижний Новгород;
² Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники имени В.Г. Мокерова РАН, Москва.
- 15⁰⁰ – 15³⁰ **К.О.Болтарь**, И.Д.Бурлаков, А.В.Полесский, Н.И.Яковлева
Фотосенсорика коротковолнового ИК диапазона спектра (приглашенный доклад)
ГНЦ РФ АО «НПО «Орион».

15³⁰ – 15⁴⁵

О.Н.Шевченко^{1,2}, **Н.А.Николаев**^{1,2}, **К.А.Кох**^{2,3}.

Детектирование ТГц волн в кристаллах GaSe:S с помощью фемтосекундных лазерных импульсов на длине волны 1550 нм.

¹ *Институт автоматики и электрометрии СО РАН, Новосибирск;*

² *Новосибирский государственный университет, Новосибирск;*

³ *Институт геологии и минералогии СО РАН, Новосибирск.*

15⁴⁵ – 16⁰⁰

М.В.Дорохин¹, **М.В.Ведь**¹, **П.Б.Дёмин**¹, **Д.В.Хомицкий**¹, **К.С.Кабаев**¹, **F.Iikawa**², **M.A.G.Balanta**², **Б.Н.Звонков**¹.

Циркулярно-поляризованная фотолюминесценция в наноструктурах InGaAs/GaAs, дельта-легированных Mn.

¹ *Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород;*

² *Instituto do Fisica "Gleb Watagin", Campinas, Brazil*

16⁰⁰ – 16¹⁵

С.А.Кузнецов^{1,2}, **А.В.Гельфанд**¹, **А.А.Мамрашев**³, **Ф.А.Минаков**³, **Н.А.Николаев**^{2,3}.

Высокоэффективные поляризаторы с металлической решеткой на несущих полимерных пленках для широкополосной терагерцовой спектроскопии.

¹ *Филиал ИФП СО РАН «КТИПМ», Новосибирск;*

² *Аналитический и технологический исследовательский центр ФФ НГУ, Новосибирск;*

³ *Институт автоматики и электрометрии СО РАН, Новосибирск.*

16¹⁵ – 16³⁰

Д.С.Конради¹, **М.В.Сахаров**², **В.Г.Средин**¹, **И.В.Кузнецов**¹.

Влияние лазерной засветки на распознавание объектов оптико-электронными системами на основе ИК матричных фотоприемных устройств.

¹ *Военная академия РВСН им. Петра Великого, Балашиха;*

² *12ЦНИИ МО РФ, Сергиев Посад.*

16³⁰ – 16⁵⁰

Кофе-брейк

16⁵⁰ – 18³⁰

Стендовая секция – 1.

ВТОРНИК, 5 ОКТЯБРЯ

4-е заседание Председатель – Терещенко О.Е.

- 9⁰⁰ – 9³⁰ **С.А.Бабин**^{1,2}, М.И.Скворцов¹, А.А.Вольф¹, А.В.Достовалов¹, С.Р.Абдуллина¹, А.А.Власов¹.
Волоконные лазеры с распределенной обратной связью на основе регулярных и случайных структур показателя преломления (**приглашенный доклад**).
¹ Институт автоматики и электрометрии СО РАН, Новосибирск;
² Новосибирский государственный университет, Новосибирск.
- 9³⁰ – 9⁴⁵ **Н.Н.Михайлов**¹, С.А.Дворецкий^{1,3}, Р.В.Меньшиков¹, В.Г.Ремесник¹, И.Н.Ужаков¹, В.А.Швец^{1,2}.
МЛЭ рост сложных фотоприёмных, лазерных и nВп структур на основе твердых растворов CdHgTe.
¹ Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск;
² Новосибирский государственный университет, Новосибирск;
³ Томский государственный университет, Томск.
- 9⁴⁵ – 10⁰⁰ **И.И.Кремис**, Р.А.Гладков, А.С.Турбин, Е.А.Крапивко, П.А.Алдохин, В.С.Калинин, В.В.Васильев, А.А.Моисеев.
Малогабаритная тепловизионная камера с микросканированием на базе отечественного матричного КРТ фотоприемника.
Филиал ИФП СО РАН «КТИПМ».
- 10⁰⁰ – 10¹⁵ **В.А.Голяшов**^{1,2}, Д.А.Кустов¹, В.С.Русецкий^{2,3}, Т.С.Шамирзаев^{1,2}, А.В.Миронов², А.Ю.Демин², В.В.Аксенов², О.Е.Терещенко^{1,2}.
Оптический детектор спина свободных электронов с пространственным разрешением на основе полупроводниковых гетероструктур.
¹ Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск;
² Новосибирский государственный университет, Новосибирск;
³ ЗАО "ЭКРАН-ФЭП", Новосибирск.
- 10¹⁵ – 10³⁰ **С.А.Кузнецов**^{1,2}, А.В.Гельфанд¹, П.А.Лазорский¹, В.Н.Федоринин¹, А.В.Аржанников^{2,3}, Н.А.Николаев^{2,4}, А.А.Мамрашев⁴, А.А.Рыбак^{2,4}, А.Н.Генцелев³, В.П.Бессмельцев⁴.
Высокоэффективные квазиоптические частотные фильтры ТГц диапазона на основе частотно-избирательных поверхностей.
¹ Новосибирский филиал ИФП СО РАН "КТИПМ", Новосибирск;
² Новосибирский государственный университет, Новосибирск;
³ Институт ядерной физики им. Г.И.Будкера СО РАН, Новосибирск;
⁴ Институт автоматики и электрометрии СО РАН, Новосибирск.
- 10³⁰ – 10⁴⁵ **Ф.А.Минаков**, А.А.Мамрашев, В.Д.Анцыгин, Н.А.Николаев.
Поляризационно-чувствительная терагерцовая спектроскопия анизотропных кристаллов.
Институт автоматики и электрометрии СО РАН, Новосибирск.
- 10⁴⁵ – 11⁰⁰ **В.Н.Федоринин**¹, С.А.Кузнецов^{1,2}, А.В.Гельфанд¹, А.Ю.Горшков¹.
Эллипсометрия субмиллиметрового диапазона в задачах диагностики композиционных материалов.
¹ Новосибирский филиал ИФП СО РАН "КТИПМ", Новосибирск;
² Новосибирский государственный университет, Новосибирск.
- 11⁰⁰ – 11³⁰ Кофе-брейк

5-е заседание Председатель – Сидоров Г.Ю.

- 11³⁰ – 12⁰⁰ **М.В.Якунин¹**, С.М.Подгорных¹, А.В.Суслов², С.С.Криштопенко³, B.Jouault³, W.Desrat³, F.Терре³, В.Н.Неверов¹, М.Р.Попов¹, Н.Н.Михайлов⁴, С.А.Дворецкий⁴.
Исследования энергетического спектра квазидвумерных структур HgTe/CdHgTe магнитотранспортными методами (**приглашенный доклад**).
¹ Институт физики металлов им. М.Н. Мухомова УрО РАН, Екатеринбург;
² National High Magnetic Field Laboratory, Florida State University, Tallahassee, Florida, USA;
³ Laboratoire Charles Coulomb, Centre National de la Recherche Scientifique, University of Montpellier, Montpellier, France;
⁴ Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск.
- 12⁰⁰ – 12¹⁵ **Д.В.Горшков**, В.С.Варавин, Г.Ю.Сидоров, В.Г.Ремесник, И.В.Сабина.
Восстановление р-типа проводимости HgCdTe после плазмохимического травления при низких температурах.
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск.
- 12¹⁵ – 12³⁰ **А.В.Кацюба¹**, А.В.Дзуреченский^{1,2}, Г.Н.Камаев¹, В.А.Володин^{1,2}.
Формирование пленки CaSi₂ в условиях радиационного воздействия на структуру CaF₂/Si.
¹ Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск;
² Новосибирский государственный университет, Новосибирск.
- 12³⁰ – 12⁴⁵ **Д.М.Ежов**, Е.С.Савельев, Е.Д.Фахрутдинова, В.А.Светличный.
Использование магнитных наночастиц в устройствах управления ТГц излучением.
Томский государственный университет, Томск.
- 12⁴⁵ – 13⁰⁰ В.В.Васильев, **А.В.Вишняков**, Г.Ю.Сидоров, В.А.Стучинский.
Определение частотно-контрастной характеристики ИК объективов.
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск.
- 13⁰⁰ – 13¹⁵ **А.Г.Милёхин^{1,2}**, Н.Н.Курусь¹, Л.С.Басалаева¹, К.В.Аникин¹, Т.А.Дуда¹, Е.Е.Родякина^{1,2}, Р.Б.Васильев³, I.A.Milekhin⁴, M.Rahaman⁴, D.R.T.Zahn⁴, А.В.Латышев^{1,2}.
Комбинационное рассеяние света полупроводниковых структур с нанометровым пространственным разрешением.
¹ Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск;
² Новосибирский государственный университет, Новосибирск;
³ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва,
⁴ Semiconductor Physics, Chemnitz University of Technology, Chemnitz, Germany.
- 13¹⁵ – 14³⁰ Обед

6-е заседание Председатель – Морозов С.В.

- 14³⁰ – 15⁰⁰ **М.М.Глазов**
Экситоны и трионы в оптическом отклике двумерных кристаллов (приглашенный доклад).
Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе, Санкт-Петербург.
- 15⁰⁰ – 15³⁰ **С.В.Гапоненко**
Перспективы коллоидной оптоэлектроники (приглашенный доклад).
Институт физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси, Беларусь
- 15³⁰ – 15⁴⁵ **В.С.Полов**^{1,2}, В.П.Пономаренко^{1,2}, П.И.Абрамов¹.
Фотоэлектроника на основе коллоидных наноматериалов.
¹ Государственный научный центр РФ АО «НПО «Орион», Москва;
² Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), Долгопрудный.
- 15⁴⁵ – 16⁰⁰ **А.С.Голтаев**¹, А.М.Можаров¹, В.В.Ярошенко², Д.А.Зуев², И.С.Мухин¹.
Исследование однофотонной излучающей системы на основе NV-центров в наноалмазах, интегрированных с ННК GaP.
¹ Академический университет им. Ж.И. Алфёрова, Санкт-Петербург;
² Университет ИТМО, Санкт-Петербург.
- 16⁰⁰ – 16¹⁵ **В.А.Холоднов**^{1,2}.
О возможности регулирования фотоэлектрического отклика полупроводников специальным пространственным профилированием потока излучения.
¹ Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Москва;
² ОАО «НПО «Орион», Москва.
- 16¹⁵ – 16³⁰ Кофе-брейк
- 16³⁰ – 18³⁰ **Стендовая сессия - 2**

СРЕДА, 6 ОКТЯБРЯ

7-е заседание Председатель – Терехов А.С.

- 9⁰⁰ – 9³⁰ **В.А.Гайслер**, И.А.Деребезов, А.В.Гайслер, Д.В.Дмитриев, А.И.Торопов
Сверхминиатюрные излучатели на основе полупроводниковых наноструктур (**приглашенный доклад**)
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск
- 9³⁰ – 9⁴⁵ **В.А.Ткаченко**, О.А.Ткаченко, А.С.Ярошевич, З.Д.Квон, Е.Е.Родякина, А.В.Латышев.
СВЧ-фотоконтактанс квантового точечного контакта.
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск.
- 9⁴⁵–10⁰⁰ **О.И.Семенова**
Гибридные перовскиты – прорыв в солнечной энергетике.
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова, Новосибирск.
- 10⁰⁰ – 10¹⁵ **К.В.Феклистов**¹, А.Г.Лемзяков³, А.А.Шкляев^{1,2}, Г.К.Кривякин^{1,2}, А.И.Комонов¹, И.П.Просвирин⁴, Д.В.Гуляев¹, Д.С.Абрамкин¹, Е.В.Спесивцев¹, А.М.Пугачев⁵.
Барьеры для инжекции носителей в ВЧ-магнетронно напыленные пленки In₂O₃:Er на кремнии.
¹ Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск;
² Новосибирский государственный университет, Новосибирск;
³ Институт ядерной физики СО РАН, Новосибирск;
⁴ ИК СО РАН, Новосибирск;
⁵ ИАИЭ СО РАН, Новосибирск.
- 10¹⁵ – 10³⁰ К.А.Свит¹, **А.А.Зарубанов**¹, Т.А.Дуда¹, С.В.Трубина², В.В.Зверева², Е.В.Федосенко², К.С.Журавлев^{1,3}.
Кристаллическая структура и преобладающие дефекты в квантовых точках CdS сформированные методом Ленгмюра-Блоджетт.
¹ Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова, Новосибирск;
² Институт неорганической химии им. А.В. Николаева, Новосибирск;
³ Новосибирский государственный университет, Новосибирск.
- 10³⁰ – 10⁴⁵ **А.В.Царев**^{1,2}
Новый тип оптического сенсора в структуре кремний на изоляторе.
¹ Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН, Новосибирск;
² Новосибирский государственный университет, Новосибирск.
- 10⁴⁵ – 11⁰⁰ **К.А.Лозовой**, В.В.Дирко, А.П.Коханенко, А.В.Войцеховский.
Моделирование особенностей эпитаксиального формирования 2D- и 3D-островков с учетом изменения физических параметров двумерных пленок с толщиной с учетом изменения физических параметров двумерных пленок с толщиной.
Томский государственный университет, Томск
- 11⁰⁰ – 11²⁰ Кофе-брейк

8-е заседание Председатель – Журавлев К.С.

- 11²⁰ – 11⁵⁰ **Е.В. Гаврилов, Д.В. Брунёв, В.М. Тимофеев.**
Опыт и перспективы перехода оптико-электронного приборостроения на отечественную элементную базу
(приглашенный доклад).
АО «НПК ПЕЛЕНГАТОР», Санкт-Петербург.
- 11⁵⁰ – 12⁰⁵ **В.В. Герасимов^{1,2}, А.К. Никитин^{2,3}, О.В. Хитров³, А.Г. Лемзяков^{1,2}.**
Измерение оптических свойств металл-диэлектрических поверхностей с помощью терагерцовой поверхностно-плазмонной интерферометрии.
¹ Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирск;
² Новосибирский государственный университет, Новосибирск;
³ Научно-технологический центр уникального приборостроения РАН, Москва.
- 12⁰⁵ – 12²⁰ **Н.Н. Курусь¹, И.А. Милёхин², Н.А. Небогатикова¹, И.В. Антонова^{1,3}, Е.Е. Родякина^{1,3}, А.Г. Милёхин¹, А.В. Латышев^{1,3}.**
Исследование комбинационного рассеяния света графеном с нанометровым пространственным разрешением.
¹ Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск;
² Semiconductor Physics, Chemnitz University of Technology, D-09107 Chemnitz, Germany;
³ Новосибирский государственный университет, Новосибирск.
- 12²⁰ – 12³⁵ **В.Г. Мансуров, Ю.Г. Галицын, Т.В. Малин, Д.С. Милахин, А.С. Петров, К.С. Журавлев.**
Процессы формирования упорядоченных двумерных фаз кремния (пористого силицена) на поверхности g-Si₃N₄/Si(111).
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова, Новосибирск.
- 12³⁵ – 12⁵⁰ **А.М. Можаров¹, К.Ю. Шугуров¹, Г.А. Сапунов¹, В.В. Федоров¹, И.С. Мухин^{1,2}.**
Исследование работы диода Ганна в рамках новой многодолинной модели зоны проводимости.
¹ СПБАУ РАН, Академический университет, Санкт-Петербург;
² Университет ИТМО, Санкт-Петербург.
- 12⁵⁰ – 13⁰⁵ **В.Н. Трухин¹, И.А. Мусмафин¹, F. V. Kusmartsev^{2,3}, A. Kusmartseva², Y. Liu³, B. Zhang³, Y. Luo³.**
Генерация терагерцового излучения токами фотонного увлечения в квантовых ямах α-Sn/Ge.
¹ ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург;
² Department of Physics, Loughborough University, UK;
³ Nano-fabrication laboratory, MTRC, China.
- 13⁰⁵ – 14⁰⁰ Обед
- 15⁰⁰ – 18⁰⁰ Экскурсии

ЧЕТВЕРГ, 7 ОКТЯБРЯ

9-е заседание Председатель – Двуреченский А.В.

- 9⁰⁰ – 9³⁰ **В.В.Бакин¹, Ю.Б.Болховитянов¹, С.Н.Косолобов¹, С.А.Рожков^{1,2}, Г.Э.Шайблер^{1,2}, А.С.Терехов¹**.
Полупроводниковые фотокатоды с эффективным отрицательным электронным сродством для научных и специальных применений (**приглашенный доклад**).
¹ *Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск;*
² *Новосибирский государственный университет, Новосибирск.*
- 9³⁰ – 9⁴⁵ **Г.Э.Шайблер^{1,2}, С.Н.Косолобов¹, А.С.Терехов¹, L.B.Jones^{3,4}, B.L.Militsyn^{3,4}, T.C.Q.Noakes^{3,4}**.
Эволюция средней поперечной энергии электронов, эмитированных р-GaAs(Cs,O) фотокатодом, в процессе его кислород-индуцированной деградации.
¹ *Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск;*
² *Новосибирский государственный университет, Новосибирск;*
³ *ASTeC, STFC Daresbury Laboratory, Warrington, Cheshire, UK;*
⁴ *Cockcroft Institute of Accelerator Science and Technology, Warrington, UK.*
- 9⁴⁵ – 10⁰⁰ **Н.Л.Шварц^{1,2}, А.А.Спирина¹**.
Влияние ориентации поверхности на характеристики высокотемпературных отжигов подложек арсенида галлия.
¹ *Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск;*
² *Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск.*
- 10⁰⁰ – 10¹⁵ **Н.Н.Рубцова¹, А.А.Ковалёв¹, Д.В.Ледовских¹, В.В.Преображенский¹, М.А.Путятю¹, Б.Р.Семягин¹, С.А.Кузнецов², В.С.Пивцов²**.
Свойства квантовых ям и их применение в компактных лазерах ближнего ИК диапазона.
¹ *Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск;*
² *Институт лазерной физики СО РАН, Новосибирск.*
- 10¹⁵ – 10³⁰ **С.Н.Подлесный¹, И.А.Карташов¹, В.П.Попов¹, И.Н.Куприянов², Ю.Н.Пальянов²**.
Ансамбли NV- центров квантового качества в высокочистом алмазе после горячей имплантации и высокотемпературного отжига под давлением.
¹ *Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск;*
² *Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, Новосибирск.*
- 10³⁰ – 10⁴⁵ **Д.М.Казанцев^{1,2}, В.А.Ткаченко^{1,2}, В.Л.Альперович^{1,2}**.
Резонансный фотоотклик плавного потенциального барьера.
¹ *Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН, Новосибирск;*
² *Новосибирский государственный университет, Новосибирск.*
- 10⁴⁵ – 11⁰⁰ **С.А.Дворецкий^{1,4}, М.Ф.Ступак², Н.Н.Михайлов^{1,3}, С.Н.Макаров², А.Г.Елесин², А.Г.Верхогляд²**.
Характеризация кристаллического совершенства слоев гетероструктур (013)HgCdTe/CdTe/ZnTe/GaAs методом генерации

второй гармоники.

¹ *Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН, Новосибирск;*

² *Конструкторско-технологический институт научного приборостроения СО РАН, Новосибирск;*

³ *Новосибирский государственный университет, Новосибирск;*

⁴ *Томский государственный университет, Томск.*

11⁰⁰ – 11³⁰

Кофе-брейк

10-е заседание Председатель – Никифоров А.И.

11³⁰ – 12⁰⁰

А.А.Шкляев^{1,2}

Резонансные оптические покрытия, состоящие из массивов частиц SiGe и Ge на подложках Si (**приглашенный доклад**).

¹ *Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН, Новосибирск;*

² *Новосибирский государственный университет, Новосибирск.*

12⁰⁰ – 12³⁰

А.А.Блошкин^{1,2}, А.И.Якимов¹, В.В.Кириенко¹, А.В.Двуреченский^{1,2}, Д.Е.Уткин^{1,2}

Методы усиления фототока ближнего инфракрасного диапазона в гетероструктурах Ge/Si с квантовыми точками Ge (**приглашенный доклад**).

¹ *Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН, Новосибирск;*

² *Новосибирский государственный университет, Новосибирск.*

12³⁰ – 12⁴⁵

Ж.В.Смагина¹, В.А.Зиновьев¹, Е.Е.Родякина^{1,2}, М.В.Степихова³, А.В.Перетокин^{3,4}, С.А.Рудин¹, С.А.Дьяков⁵, А.В.Новиков³, А.В.Двуреченский^{1,2}.

Структурные и излучательные свойства упорядоченных Ge(Si) квантовых точек, встроенных в фотонные кристаллы.

¹ *Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН, Новосибирск;*

² *Новосибирский государственный университет, Новосибирск;*

³ *Институт физики микроструктур РАН, Нижегородская обл., д. Афонино;*

⁴ *НГТУ им. Р.Е. Алексеева, Нижний Новгород;*

⁵ *Центр фотоники и квантовых материалов, Сколковский институт науки и технологий, Москва.*

12⁴⁵ – 13⁰⁰

Р.В.Пресняков, С.М.Пещерова, А.Г.Чуешова, В.А.Бычинский, А.И.Непомнящих.

Фазообразование и время жизни неравновесных носителей заряда в мультикристаллическом кремнии на основе UMG-Si.

Институт геохимии им. А.П. Виноградова, Иркутск.

13⁰⁰ – 13¹⁵

В.А.Тимофеев¹, В.И.Машанов¹, А.И.Никифоров¹, А.А.Блошкин¹, И.Д.Лошкарёв¹, И.В.Скворцов¹, Д.В.Коляда², Д.Д.Фирсов², О.С.Комков².

Структурные и оптические свойства многослойных периодических структур с псевдоморфными слоями GeSiSn.

¹ *Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова, Новосибирск;*

² *СПб ГЭТУ «ЛЭТИ», Санкт-Петербург.*

13¹⁵ – 14³⁰

Обед

11-е заседание Председатель – Шкляев А.А.

- 14³⁰ – 15⁰⁰ **А.В.Новиков¹, М.В.Степихова¹, С.А.Дьяков², М.В.Шалеев¹, Д.В.Юрасов¹, Е.Е.Родякина¹, А.Н.Яблонский¹, В.А.Вербус¹, М.И.Петров⁴, V.Rutckaia⁵, J.Schilling⁵, З.Ф.Красильник¹.**
Диэлектрические микро- и нанорезонаторы на светоизлучающих SiGe структурах (**приглашенный доклад**).
¹ ИФМ РАН, Нижегородская обл., д. Афонино;
² Сколковский институт науки и технологий, Москва;
³ Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН, Новосибирск;
⁴ Университет ИТМО, Санкт-Петербург;
⁵ Martin-Luther-University Halle-Wittenberg, Germany.
- 15⁰⁰ – 15³⁰ **С.В. Морозов**
Стимулированное излучение в диапазоне 10-31 мкм в гетероструктурах с квантовыми ямами HgTe/CdHgTe с диэлектрическим и «фононным» волноводами (**приглашенный доклад**).
Институт физики микроструктур РАН, Нижний Новгород.
- 15³⁰ – 15⁴⁵ **М.В.Степихова¹, К.В.Барышникова², М.И.Петров², V.Rutckaia³, А.В.Перетокин¹, А.Н.Яблонский¹, А.В.Новиков¹, J.Schilling³, З.Ф.Красильник¹.**
Резонансы Ми и коллективные явления в спектрах фотолюминесценции одиночных резонаторов и их цепочек, сформированных на кремниевых структурах с наноостровками Ge(Si).
¹ Институт физики микроструктур РАН, д. Афонино, Нижегородская обл.;
² Университет ИТМО, Санкт-Петербург;
³ Martin-Luther-University Halle-Wittenberg, Halle (Saale), Germany.
- 15⁴⁵ – 16⁰⁰ **Н.А.Лаврентьев^{1,2}, Е.В.Мирофяненко¹, А.Е.Мирофяненко¹, В.С.Попов^{1,2}.**
Получение двумерных нанокристаллов Bi₂Te₃ методом жидкофазной эксфолиации для использования в датчиках ИК диапазона спектра.
¹ Государственный научный центр РФ АО «НПО»Орион», Москва;
² Московский физико-технический институт, Долгопрудный.
- 16⁰⁰ – 16¹⁵ Кофе-брейк

12-е заседание Председатель – Терещенко О.Е.

- 16¹⁵ – 16⁴⁵ **С.А.Тарасенко.**
Краевые фотогальванические эффекты в двумерных кристаллах (**приглашенный доклад**).
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург
- 16⁴⁵ – 17¹⁵ **А.В.Галеева¹, А.С.Казаков¹, А.И.Арташкин¹, А.В.Иконников¹, Л.И.Рябова², С.А.Дворецкий³, Н.Н.Михайлов³, М.И.Банников⁴, С.Н.Данилов⁵, Д.Р.Хохлов^{1,4}.**
Нелокальная киральная терагерцовая фотопроводимость в гетероструктурах на основе топологической фазы Hg_{1-x}Cd_xTe (**приглашенный доклад**).
¹ Физический факультет, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва;
² Химический факультет, Московский государственный

университет им. М.В. Ломоносова, Москва;

³ Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск;

⁴ Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва;

⁵ University of Regensburg, Regensburg, Germany.

17¹⁵ – 17³⁰

М.В.Степихова¹, С.А.Дьяков², А.Н.Яблонский¹, А.В.Перетокин¹,
Д.В.Юрасов¹, М.В.Шалеев¹, Н.А.Гиппиус², А.В.Новиков¹,
З.Ф.Красильник¹.

Проявления связанных состояний в континууме в люминесцентном отклике наноструктур Ge(Si) в двумерных фотонных кристаллах.

¹ Институт физики микроструктур РАН, д. Афонино, Нижегородская обл.;

² СПб ПГУ, Санкт-Петербург.

17³⁰ – 17⁴⁵

А.С.Петров

Межкраевой плазмон Берри как основа регулируемых однонаправленных устройств без магнитного поля.

Московский физико-технический институт, Долгопрудный

17⁴⁵ – 18⁰⁰

Л.Н.Дворецкая¹, А.М.Можаров¹, В.В.Фёдоров¹, И.С.Мухин^{1,2}.

Использование микросферной фотолитографии для селективного синтеза полупроводниковых структур группы A₃B₅ на Si.

¹ СПбАУ РАН, Академический университет, Санкт-Петербург;

² Университет ИТМО, Санкт-Петербург

ПЯТНИЦА, 8 ОКТЯБРЯ

13-е заседание Председатель – Преображенский В.В.

- $9^{00} - 9^{30}$ **К.С.Журавлев**¹, А.С. Башкатов², О.Н. Морозова².
Перспективные гетероструктуры на основе A_3B_5 полупроводников для фотоприемников ближнего и среднего ИК диапазонов спектра (**приглашенный доклад**).
¹Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск;
² ФГУП «МНИИРИП», Мытищи.
- $9^{30} - 10^{00}$ **О.Е.Терещенко**^{1,2}, С.В.Иванов³, Н.А.Половников¹, А.А.Соколов³, В.С.Русецкий^{1,4}, В.А.Голяшов^{1,2}, А.С.Ярошевич¹, А.В.Миронов⁴, А.Ю.Дёмин⁴.
Новая концепция пировидикона на основе пироэлектрического электронно-оптического преобразователя диапазона 1-12 мкм (**приглашенный доклад**).
¹ Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск;
² Новосибирский государственный университет, Новосибирск;
³ Институт автоматики и электрометрии СО РАН, Новосибирск;
⁴ ЗАО «ЭКРАН-ФЭП», Новосибирск.
- $10^{00} - 10^{15}$ **М.А.Суханов**, А.К.Бакаров, И.Д.Лошкарёв, К.С.Журавлев.
InSb/InAlSb гетероструктуры для ИК фотоприемников с повышенной рабочей температурой.
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск.
- $10^{15} - 10^{30}$ **О.Э.Камешков**^{1,2}, В.В.Герасимов^{1,2}, Б.А.Князев^{1,2}.
Численное моделирование сенсоров на основе линейных металлических решеток.
¹ Новосибирский государственный университет, Новосибирск;
² Институт ядерной физики им. Будкера СО РАН, Новосибирск.
- $10^{30} - 10^{45}$ **А.В.Царев**^{1,2}, Р.М.Тазиев¹.
Особенности моделирования интегрально-оптических элементов для радиофотоники.
¹ Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН, Новосибирск;
² Новосибирский государственный университет, Новосибирск.
- $10^{45} - 11^{00}$ **Д.В.Гуляев**, Д.В.Дмитриев, Е.А.Колосовский, А.В.Царев, К.С.Журавлев.
Гетероструктуры InGaAlAs/InAlAs на фосфид индиевой подложке для электрооптического модулятора Маха-Цендера.
Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН, Новосибирск.
- $11^{00} - 11^{30}$ Кофе-брейк

14-е заседание Председатель – Федорин В.Н.

- 11³⁰ – 11⁴⁵ *А.В.Голицын¹, А.А.Голицын^{1,2}, А.О.Лебедев¹, Б.Н.Новгородов, А.Р.Новоселов¹, А.Г.Паулиш^{1,2,3}, **С.М.Чурилов¹**, П.И.Шапор¹, К.П.Шатунов¹.*
Направления развития оптико-электронных систем и приборов в Филиале ИФП СО РАН "КТИПМ".
¹ Новосибирский филиал ИФП СО РАН "КТИПМ", Новосибирск;
² Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск;
³ Новосибирский государственный университет, Новосибирск.
- 11⁴⁵ – 12⁰⁰ **Б.Г.Вайнер^{1,2}**.
Матричное тепловидение нового поколения в химии и химической физике.
¹ Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск;
² Новосибирский государственный университет, Новосибирск.
- 12⁰⁰ – 12¹⁵ **Р.А.Гладков**, И.И.Кремис.
Микросканер для тепловизора третьего поколения.
Новосибирский филиал ИФП СО РАН "КТИПМ", Новосибирск.
- 12¹⁵ – 12³⁰ **В.А.Швец^{1,2}**, Д.В.Марин¹, И.А.Азаров¹, М.В.Якушев¹, С.В.Рыхлицкий¹.
Эллипсометрическая in situ диагностика температуры в технологии выращивания слоёв кадмий-ртуть-теллур методом молекулярно-лучевой эпитаксии.
¹ Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск;
² Новосибирский государственный университет, Новосибирск.
- 12³⁰ – 13⁰⁰ **Закрытие конференции**

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ОКТЯБРЯ

Стендовая секция-1

- П1. **В.П.Лесников¹, М.В.Ведь¹, О.В.Вихрова¹, Ю.А.Данилов¹, П.Б.Демина¹, Н.В.Дикарева¹, М.В.Дорохин¹, Е.Б.Якимов², Б.Н.Звонков¹, А.В.Здоровейцев¹, В.А.Ковальский², Р.Н.Крюков¹.**
Арсенид-галлиевые структуры с углеродным покрытием:
многофункциональное применение для приборов оптоэлектроники и бета-вольтаики.
¹ Научно-исследовательский физико-технический институт
Нижегородского государственного университета им. Н.И.
Лобачевского, Нижний Новгород;
² Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых
материалов РАН, Черноголовка.
- П2. **Д.В.Гуляев¹, Д.В.Дмитриев¹, Д.Ю.Протасов^{1,2}, Н.В.Фатеев¹, А.С.Кожухов¹, К.С.Журавлев¹.**
GaAs/AlGaAs и InGaAs/AlGaAs гетероструктуры для полупроводниковых
инфракрасных излучателей.
¹ Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН,
Новосибирск;
² Новосибирский государственный технический университет,
Новосибирск
- П3. **Д.В.Дмитриев¹, Д.А.Колосовский^{1,2}, А.И.Торопов¹, К.С.Журавлев¹.**
Удаление оксида с поверхности InP(001) в потоке мышьяка.
¹ Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН,
Новосибирск;
² Новосибирский государственный университет, Новосибирск.
- П4. **В.А.Зиновьев¹, А.В.Кацюба¹, В.А.Володин^{1,2}, А.Ф.Зиновьева^{1,2}, С.Г.Черкова², Ж.В.Смагина², А.В.Двуреченский^{1,2}, А.Ю.Крупин³, О.М.Бородавченко⁴, В.Д.Живулько⁴, А.В.Мудрый⁴.**
Оптические и структурные свойства двумерных слоёв кремния,
встроенных в диэлектрическую матрицу фторида кальция.
¹ Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН,
Новосибирск;
² Новосибирский государственный университет, Новосибирск;
³ Новосибирский государственный технический университет,
Новосибирск;
⁴ ГО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению», Минск, Беларусь.
- П5. **Д.В.Ищенко, И.О.Ахундов, А.С.Кожухов, Н.П.Стёпина, А.С.Тарасов, Е.В.Федосенко, О.Е.Терещенко.**
Рост Ван-дер-Ваальсовых материалов на Si(111)
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН,
Новосибирск.
- П6. **Г.Н.Камаев^{1,2}, А.В.Кацюба¹, П.А.Кучинская¹, В.А.Володин^{1,2}, А.В.Двуреченский^{1,2}.**
Формирование массивов нанокристаллов Si и твердого раствора SiGe на
неориентирующей диэлектрической подложке.
¹ Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН,
Новосибирск;
² Новосибирский государственный университет, Новосибирск.

- П7. **Д.А.Колосовский, Д.В.Дмитриев, С.А.Пономарев, А.И.Торопов, К.С.Журавлев.**
Формирования InAs островков на поверхности InP(001) при высокотемпературном отжиге в потоке мышьяка.
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск.
- П8. **А.П.Коханенко, В.В.Дирко, О.И.Кукенов, А.С.Соколов.**
Экспериментальное исследование изменения параметров растущих двумерных пленок с толщиной при их эпитаксиальном выращивании.
Томский государственный университет, Томск
- П9. **Я.Е.Майдэбура, В.Г.Мансуров, Т.В.Малин, К.С.Журавлев.**
Преобразование элементного состава на поверхности 2D слоя GaN при формировании квантовых точек GaN.
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск.
- П10. **Д.А.Андрющенко¹, М.С.Ружевич¹, А.М.Смирнов¹, К.Д.Мынбаев^{1,2}, Н.Л.Баженов², В.Г.Ремесник³.**
Оптические и структурные свойства образцов $\text{Cd}_{0.3}\text{Hg}_{0.7}\text{Te}$, выращенных различными методами.
¹ *Университет ИТМО, Санкт-Петербург;*
² *ФТИ им. А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург;*
³ *Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск.*
- П11. **А.Г.Настовьяк, Н.Л.Шварц.**
Моделирование структурного полиморфизма в нанопроволоках GaAs на базе решеточной модели.
¹ *Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск;*
² *Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск.*
- П12. **В.С.Ковшов^{1,2}, А.В.Никонов².**
Метод расчета эффективной ширины запрещенной зоны сверхрешеток 2 типа на основе InAs/GaSb.
¹ *АО «НПО «Орион», Москва;*
² *МФТИ (НИУ), Долгопрудный.*
- П13. **А.С.Тарасов¹, Д.В.Ищенко¹, Н.Н.Михайлов^{1,2}, С.А.Дворецкий^{1,3}, Р.В.Менщиков¹, И.Н.Ужаков¹, А.С.Кожухов¹, И.Д.Лошкарев¹, А.Э.Климов^{1,4}, Е.В.Федосенко¹, О.Е.Терещенко^{1,2}.**
Анизотропия проводимости эпитаксиальных плёнок топологического кристаллического изолятора $\text{Pb}_{1-x}\text{Sn}_x\text{Te}$, выращенных на подложках CdTe/ZnTe/GaAs (013).
¹ *Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск;*
² *Новосибирский государственный университет, Новосибирск;*
³ *Томский государственный университет, Томск;*
⁴ *Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск.*
- П14. **И.О.Ахундов¹, В.А.Голяшов^{1,2}, Д.В.Ищенко¹, А.Э.Климов^{1,2}, Е.Л.Молодцова¹, Н.С.Пашин¹, С.П.Супрун¹, А.С.Тарасов¹, Е.В.Федосенко¹, В.Н.Шерстякова¹, О.Е.Терещенко^{1,3}.**
Влияние химической обработки на электрофизические свойства топологического кристаллического изолятора $\text{Pb}_{1-x}\text{Sn}_x\text{Te}:\text{In}$ (111).
¹ *Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск;*

² Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск;

³ Новосибирский государственный университет, Новосибирск.

П15. **Д.Е.Уткин**^{1,2}, А.А.Шкляев^{1,2}.

Формирование упорядоченных субмикронных частиц Ge и Si на поверхности SiO₂ подложки методом lift-off.

¹ Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск;

² Новосибирский государственный университет, Новосибирск.

П16. **С.Г.Черкова**¹, В.А.Володин^{1,2}, Г.К.Кривякин^{1,2}, В.А.Скуратов³.

Инфракрасная фотолюминесценция в кремнии, облученном тяжелыми ионами высоких энергий.

¹ Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск;

² Новосибирский государственный университет, Новосибирск;

³ Объединенный институт ядерных исследований, Дубна.

П17. **Л.С.Басалаева**¹, Т.А.Дуда¹, К.В.Аникин¹, Б.М. Саиджонов², Р.Б.Васильев², А.Г.Милехин¹.

Локализованные оптические фононы в нанопластинках ZnSe.

¹ Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск;

² Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва.

П18. **Р.И.Баталов**¹, Р.М.Баязитов¹, Г.А.Новиков¹, В.И.Нуждин¹, В.Ф.Валеев¹, К.Н.Галкин², И.Б.Чистохин³, Г.Д.Излев⁴, Ф.Ф.Комаров⁴.

Формирование фотодиодных n+/p-Si структур с примесями халькогенов и металлов методами ионной имплантации и импульсных воздействий.

¹ Казанский физико-технический институт, Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр РАН», Казань;

² Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН, Владивосток;

³ Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск;

⁴ Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь.

П19. М.В.Дорохин, П.Б.Демина, Б.Н.Звонков, А.В.Здоровейщев, **Н.В.Дикарева**.

Циркулярно-поляризованное излучение в торцевых GaAs/InGaAsP/InGaAs лазерах с ферромагнитными зеркалами.

ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород.

П20. А.А.Семакова^{1,2}, А.М.Смирнов¹, Н.Л.Баженов², **К.Д.Мынбаев**^{1,2}, А.В.Черняев^{2,3}, С.С.Кижеев³, Н.Д.Стойнов³.

Исследование оптических и структурных свойств эпитаксиальных слоёв InAs(Sb,Ga), выращенных на подложках из InAs.

¹ Университет ИТМО, Санкт-Петербург;

² ФТИ им. А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург;

³ ООО «Микросенсор Технолоджи», Санкт-Петербург.

П21. **Д.Ю.Протасов**^{1,2}, К.С.Журавлев¹.

Распределенный береговой отражатель с улучшенной угловой зависимостью коэффициента отражения.

¹ Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск;

² Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск.

- П22. **Д.Б.Третьяков**^{1,2}, А.В.Коляко^{1,2}, А.С.Плешков^{1,2}, В.М.Энтин^{1,2}, И.И.Рябцев^{1,2}, В.В.Преображенский¹, И.Б.Чистохин¹, И.Г.Неизвестный^{1,3}.
Применение кремниевых лавинных фотодиодов для регистрации одиночных фотонов в установке по квантовой криптографии.
¹ Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск;
² Новосибирский государственный университет, Новосибирск;
³ Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск.
- П23. **И.А.Александров**¹, Т.В.Малин¹, Д.Ю.Протасов¹, В.Резз², К.С.Журавлев¹.
Фотолюминесценция множественных квантовых ям GaN/AlN.
¹ Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск;
² Institute for Technical Physics and Materials Science, Budapest, Hungary.
- П24. **В.С.Русецкий**^{1,2}, В.А.Голяшов¹, А.В.Миронов², А.Ю.Дёмин², О.Е.Терещенко¹.
Источник спин-поляризованных электронов на основе мультищелочного фотокатода.
¹ Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск;
² ЗАО Экран ФЭП, Новосибирск.
- П25. **А.А.Рыбак**^{1,2}, Н.А.Николаев¹, В.Д.Анцыгин¹, А.А.Мамрашев¹.
Оптические терагерцовые свойства электрида $12\text{CaO} \cdot 7\text{Al}_2\text{O}_3$ (C_{12}A_7).
¹ Институт автоматики и электрометрии СО РАН, Новосибирск;
² Новосибирский государственный университет, Новосибирск.
- П26. **Н.А.Николаев**¹, А.А.Рыбак^{1,2}, А.А.Мамрашев¹, В.Д.Анцыгин¹.
Терагерцовые свойства сегнетоэлектриков KTiOPo_4 , KTiOAsO_4 и KNbO_3 .
¹ Институт автоматики и электрометрии СО РАН, Новосибирск;
² Новосибирский государственный университет, Новосибирск.
- П27. **А.А.Шалаев**^{1,2}, А.И.Русаков¹, Р.Ю.Шендрик¹.
Выращивание и оптические свойства сцинтилляционных кристаллов BaBrI:Sm^{2+} .
¹ Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, Иркутск;
² Иркутский государственный университет, Иркутск.
- П28. **Т.С.Шамирзаев**¹, А.К.Бакаров¹, Д.Р.Яковлев², M. Bayer².
Динамика рекомбинации и спиновой релаксации экситонов в гетероструктурах $(\text{III}, \text{Al})(\text{As}, \text{Sb})/\text{AlAs}$.
¹ Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск;
² Technische Universität Dortmund, Dortmund, Germany.
- П29. **М.С.Кораблин**^{1,2}, В.Е.Гончаров^{1,3}, **А.В.Никонов**².
Расчётная модель оптических характеристик соединения AlGaAs для контроля параметров QWIP-структур.
¹ АО «НПО «Орион», Москва;
² МФТИ (НИУ), Долгопрудный;
³ МИРЭА – Российский технологический университет, Москва.
- П30. **И.В.Осинных**^{1,2}, Т.В.Малин¹, Д.С.Милахин¹, И.А.Александров¹, К.С.Журавлев^{1,2}.
Установление типов переходов, ответственных за фиолетовую полосу фотолюминесценции в сильно легированном AlN:Si .
¹ Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск;
² Новосибирский государственный университет, Новосибирск.

- П31. **А.Е.Маричев**, В.С.Эполетов, А.С.Власов, А.И.Лихачев, А.В.Нащекин, Б.В.Пушный.
Замена туннельных переходов в структурах на основе InP на каналы проводимости.
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург.
- П32. **А.В.Марченко**^{1,2}, А.Г.Милёхин^{1,2}, Н.Н.Курусь¹.
Эмиссия света двумерными островками дисульфида молибдена.
¹ *Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск;*
² *Новосибирский государственный университет, Новосибирск.*
- П33. **В.В.Шелковников**¹, С.Л.Микерин², А.Э.Симанчук², П.А.Чубаков², Н.В.Васильева¹, С.В.Коротаев¹, Н.А.Орлова¹, В.Н.Бережная¹, И.Ю.Каргаполова¹, А.М.Максимов¹, Р.А.Ищенко¹, Н.Д.Рязанов¹.
Органические нелинейно-оптические материалы на основе дендронизованных полифтортрифенилпиразолин-дицианоизофороновых хромофоров.
¹ *Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова, СО РАН, Новосибирск;*
² *Институт автоматики и электрометрии СО РАН, Новосибирск.*
- П34. **К.А.Свит**, А.А.Зарубанов, К.С.Журавлев.
Особенности энергетической структуры и оптических свойств квантовых точек сульфида кадмия, синтезированных с помощью технологии Ленгмюра-Блоджетт.
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск.
- П35. **В.Е.Аникеева**^{1, 2}, К.Н.Болдырев^{1, 2}, О.И.Семенова³, М.Н.Попова¹
Исследование спектров поглощения и отражения высокого разрешения в терагерцовом и дальнем инфракрасном диапазоне монокристаллов гибридных металлоорганических перовскитов
¹ *Институт спектроскопии РАН, Троицк, Москва;*
² *Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва;*
³ *Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск.*

ВТОРНИК, 5 ОКТЯБРЯ

Стендовая секция-2

- B1. **В.В.Бакин¹**, С.А.Рожков^{1,2}, С.Н.Косолобов¹, Г.Э.Шайблер^{1,2}, А.С.Терехов¹.
Неупругое рассеяние горячих фотоэлектронов при выходе в вакуум из р-GaAs(Cs,O).
¹ Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск;
² Новосибирский государственный университет, Новосибирск.
- B2. **И.А.Краснова¹**, Д.В.Горшков^{1,2}, Г.Ю.Сидоров², Д.В.Марин², И.В.Сабина².
Пассивация собственным окислом поверхности CdHgTe, подвергнутой жидкостному травлению.
¹ Новосибирский государственный университет, Новосибирск;
² Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск.
- B3. **Д.С.Милахин¹**, Т.В.Малин¹, В.Г.Мансуров¹, К.С.Журавлев^{1,2}.
Анализ полупроводниковых слоев AlN на подложке сапфира (0001) методом спектроскопии поверхностных поляритонов.
¹ Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск;
² Новосибирский государственный университет, Новосибирск.
- B4. **Д.Ю.Протасов^{1,2}**, В.А.Кузнецов^{1,2}, В.Я.Костюченко^{2,3}, В.С.Варавин¹, В.В.Васильев¹.
Фотопроводимость в магнитном поле в гетероструктурах кадмий-ртуть-теллур n-типа.
¹ Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск;
² Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск;
³ Сибирский государственный университет геосистем и технологий, Новосибирск.
- B5. **Д.Е.Протопопов^{1,2}**, В.С.Хорошилов^{1,2}, Д.М.Казанцев^{1,2}, Г.Э.Шайблер^{1,2}, В.Л.Альперович^{1,2}.
Пленение излучения и субподзонный пик в спектрах квантового выхода фотоэмиссии р-GaAs(Cs,O).
¹ Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск;
² Новосибирский государственный университет, Новосибирск.
- B6. **С.А.Рожков^{1,2}**, В.В.Бакин¹, С.Н.Косолобов¹, Г.Э.Шайблер^{1,2}, А.С.Терехов¹.
Термодинамическая стабильность активирующего покрытия р-GaAs(Cs,O) фотокатода.
¹ Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск;
² Новосибирский государственный университет, Новосибирск.
- B7. **К.В.Феклистов¹**, А.Г.Лемзяков³, А.А.Шкляев^{1,2}, Г.К.Кривякин^{1,2}, А.И.Комонов¹, И.П.Просвирин⁴, Д.В.Гуляев¹, Д.С.Абрамкин¹, Е.В.Спесивцев¹, А.М.Пугачев⁵.
Механизм протекания тока в ВЧ-магнетронно напыленных пленках In₂O₃:Er на кремнии.
¹ Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск;
² Новосибирский государственный университет, Новосибирск;

³ *Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирск;*

⁴ *Институт катализа имени Г. К. Борескова СО РАН, Новосибирск;*

⁵ *Институт автоматики и электрометрии СО РАН, Новосибирск.*

- B8. **В.С.Хорошилов**^{1,2}, Д.Е.Протопопов^{1,2}, Д.М.Казанцев^{1,2}, А.Г.Журавлев^{1,2}, В.Л.Альперович^{1,2}.

ФотоэДС на поверхности сильнолегированного p-GaAs с адсорбированными слоями цезия и кислорода.

¹ *Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск;*

² *Новосибирский государственный университет, Новосибирск.*

- B9. **А.В.Вишняков**, В.А.Стучинский.

Моделирование методом Монте-Карло поведения частотно-контрастной характеристики фотоприёмных КРТ-матриц вблизи удвоенной частоты Найквиста.

Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск.

- B10. В.В.Васильев, **А.В.Вишняков**, Г.Ю.Сидоров, В.А.Стучинский.

Частотно-контрастная характеристика ИК-матриц в режиме работы с частично закрытыми пиксельными входными транзисторами.

Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск.

- B11. А.В.Войцеховский¹, **С.Н.Несмелов**¹, С.М.Дзядох¹, С.А.Дворецкий², Н.Н.Михайлов², Г.Ю.Сидоров², М.В.Якушев².

Электрические характеристики MWIR и LWIR nВn-структур на основе МЛЭ HgCdTe.

¹ *Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск;*

² *Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск.*

- B12. **Д.В.Горшков**, Г.Ю.Сидоров, Д.В.Марин, И.В.Сабина.

Исследование свойств пассивирующего покрытия Al₂O₃, выращенного при различных параметрах роста на CdHgTe.

Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск.

- B13. **К.С.Журавлев**¹, И.Б.Чистохин¹, Н.А.Валишева¹, А.М.Гилинский¹, Д.В.Дмитриев¹, В.С.Арыков², И.В.Юнусов².

Высокоскоростной фотоприёмный модуль на основе InAlAs/InGaAs/InP ррп-диода с частично обедненным слоем для оптоволоконных систем передачи данных.

¹ *Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск;*

² *ООО «Ай Эм Тех», Томск.*

- B14. А.В.Зверев, **Д.Е.Ипатов**.

Алгоритм формирования модели трехмерной сцены инфракрасного диапазона.

Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск.

- B15. **А.Г.Коротаев**¹, И.И.Ижнин^{1,2}, А.В.Войцеховский¹, К.Д.Мынбаев^{3,4}, В.С.Варавин⁵, С.А.Дворецкий^{1,5}, Н.Н.Михайлов⁵, М.В.Якушев⁵, Z.Świątek⁶.

Радиационные донорные дефекты в имплантированных As МЛЭ пленках Cd_{0.3}Hg_{0.7}Te: накопление и отжиг.

¹ *Национальный исследовательский Томский госуниверситет, Томск;*

² *Научно-производственное предприятие «Электрон-Карат», Львов;*

³ *ФТИ им. А. Ф. Иоффе, Санкт-Петербург;*

⁴ Университет ИТМО, Санкт-Петербург;

⁵ Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск;

⁶ Institute of Metallurgy and Material Science PAN, Krakow, Poland.

- B16. **В.С.Ковшов^{1,2}, А.В.Никонов², К.О.Болтарь^{1,2}**.
Исследование температурной зависимости границ спектральной характеристики чувствительности фотомодулей на основе КРТ.
¹ АО «НПО «Орион», Москва;
² МФТИ (НИУ), Долгопрудный.
- B17. **А.В.Вишняков, В.В.Васильев, В.С.Варавин, Д.В.Марин, И.В.Сабина, Г.Ю.Сидоров, В.А.Стучинский, М.В.Якушев**.
Определение объемной длины диффузии фотогенерированных носителей заряда в МЛЭ КРТ n-типа проводимости с $x=0.295$ методом сканирования светового пятна диодом фотоприёмной матрицы.
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск.
- B18. **В.А.Стучинский, А.В.Вишняков**.
Эффективные времена жизни фотогенерированных носителей заряда в фотоприёмных матрицах на основе материала кадмий-ртуть-теллур.
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск.
- B19. **В.А.Стучинский, А.В.Вишняков**.
Супер-разрешение без микросканирования: восстановление субпиксельных изображений из фотосигналов окрестных диодов матрицы как некорректно поставленная задача.
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск.
- B20. **Н.И.Яковлева¹, И.Д.Бурлаков^{1,2}, К.О.Болтарь^{1,3}**.
Фотоприёмные устройства на основе InGaAs.
¹ ГНЦ РФ АО «НПО «Орион», Москва;
² МТУ (МИРЭА), Москва;
³ МФТИ (ГУ), Долгопрудный.
- B21. **Ю.А.Якимов, И.С.Мощев, М.Л.Храпунов, В.А.Стрельцов, А.Н.Кузнецов, П.А.Кузнецов**.
БИС считывания с инкрементальным $\Delta\Sigma$ -АЦП в столбце для цифровой МФПУ сканирующего типа с режимом ВЗН.
ГНЦ АО «НПО Орион», Москва.
- B22. **А.В.Войцеховский, С.Н.Несмелов, С.М.Дзядух, Т.Н.Копылова, К.М.Дегтяренко**.
Адмиттанс МДП-структур на основе пентацена с двухслойным диэлектриком $\text{SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3$.
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск
- B23. **А.И.Козлов**.
Оптические методы обеспечения предельной эффективности преобразования изображений в мозаичных фотоприёмниках сверхвысокой размерности.
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск.
- B24. **А.И.Козлов¹, А.Р.Новоселов²**.
Фундаментальные основы технологии мозаичных фотоприёмников сверхвысокой размерности.
¹ Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск;

² Новосибирский филиал ИФП СО РАН «КТИПМ», Новосибирск.

- B25. **А.И.Козлов.**
Применение эквивалентной шуму разности температур для конгруэнтности фотоприемников сверхвысокой размерности на основе многослойных структур с квантовыми ямами.
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск.
- B26. **П.С.Загубисало, А.Р.Новоселов.**
Выбор оптимальной структуры фоточувствительной гибридной сборки на охлаждаемом пьедестале криостата.
Новосибирский филиал ИФП СО РАН «КТИПМ», Новосибирск.
- B27. **А.Р.Новоселов¹, П.А.Алдохин¹, П.П.Добровольский¹, А.Е.Маточкин².**
Влияние величины изгиба флип-чип фотоприёмника на его разрушение при многократных циклах охлаждения до температуры жидкого азота.
¹ *Новосибирский филиал ИФП СО РАН «КТИПМ», Новосибирск;*
² *Институт автоматики и электрометрии СО РАН, Новосибирск.*
- B28. **П.П.Добровольский, И.И.Кремис, С.В.Хрящев, А.Р.Новоселов, С.М.Чурилов.**
Применение теплой апертурной диафрагмы в охлаждаемых малоформатных матричных фотоприёмниках.
Новосибирский филиал ИФП СО РАН «КТИПМ», Новосибирск.
- B29. **А.Р.Новоселов.**
Скрайбирование кремниевых приборных пластин лазерным излучением в водной среде.
Новосибирский филиал ИФП СО РАН «КТИПМ», Новосибирск.
- B30. **А.Р.Новоселов, П.А.Алдохин, П.П.Добровольский, А.В.Гусаченко, Б.Н.Новгородов, К.П.Шатунов, С.М.Чурилов.**
Исследование отражения диафрагмами ИК излучения в тепловизионных приборах.
Новосибирский филиал ИФП СО РАН «КТИПМ», Новосибирск.
- B31. **А.О.Лебедев, В.В.Васильев.**
Комплекс управления БПЛА для автоматического управления полетом.
Новосибирский филиал ИФП СО РАН «КТИПМ», Новосибирск.
- B32. **Е.Р.Закиров, В.Г.Кеслер, Г.Ю.Сидоров, Д.В.Горшков, Д.В.Марин, М.В.Якушев.**
Анализ вольт-фарадных характеристик МДП-структур с ALD Al₂O₃ на n- и р Cd_xHg_{1-x}Te ($x \approx 0,22$) со сверхтонким собственным оксидом.
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск.
- B33. **В.А.Стучинский, А.В.Вишняков.**
Полуэмпирическая формула для оценки эффективной длины диффузии фотогенерированных носителей заряда в фотоприемных КРТ-матрицах с квадратными диодами в условиях сканирования линейного пятна засветки диодом при максимальном отборе фототока из абсорбера.
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск.
- B34. **Р.З.Хафизов, В.В.Старцев, В.Ю.Москвичев**
Быстродействующие болометрические матричные детекторы.
Акционерное общество «Оптико-механическое конструкторское бюро «АСТРОН», Московская область, г. Лыткарино

В35. **К.В.Аникин**¹, **I.A.Milekhin**², **А.Г.Милёхин**^{1,3}, **В.Г.Мансуров**², **Т.В.Малин**²,
К.С.Журавлев², **D.R.T. Zahn**², **А.В. Латышев**^{1,3}

ИК поглощение света на оптических фононах наноструктур AlN
с нанометровым пространственным разрешением.

¹ *Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН,
Новосибирск;*

² *Semiconductor Physics, Chemnitz University of Technology, Chemnitz,
Germany;*

³ *Новосибирский государственный университет, Новосибирск*